

**99-0249**

Invenția se referă la domeniul tehnicii radioelectronice și poate fi utilizată la obținerea heterostructurilor cu straturi subțiri de compuși binari  $A^{II}B^{VI}$  pentru producerea fotorezistoarelor și a fotoconvertoarelor.

Procedeeul de obținere a heterostructurilor cu straturi subțiri pe baza compușilor binari  $A^{II}B^{VI}$  include depunerea în vid pe substrat, în prezența gradientului de temperatură dintre evaporator și substrat, a stratului de compuși cu bandă îngustă prin metoda evaporării în volumul cvasiînchis cu tratarea termică și chimică ulterioară și a stratului de compuși cu bandă largă prin evaporare discretă.